

Aufgabe

- 1) Herstellung von verschiedenen Dünnschichten
- 2) Metallhaltige Kohlenstoff-Sensorschichten, Kontaktschichten (CrNi/Al/FeNi) oder andere Metalle

Technische Daten

Anlage:

- zwei Prozesskammern und Handlingkammer mit Sputtergerät und Substratheizung
- reaktive Sputterprozesse:
 - DC Magnetron
 - RF Magnetron
- PVD Sputterprozess
- 8 x 4" Targets
- Vollautomatischer Betrieb nach Rezepten

Substrat & Dünnschicht:

- Substratdimensionen (max.):
 - Durchmesser 200 mm
 - Höhe 30 mm
- aktive Substratheizung während des Prozesses möglich ($T_{\max} = 300\text{ °C}$)
- RF Substratbias

Funktionsweise

- Prozess- und Precursorgas über Ringgasdusche
- Reaktiver Sputterprozess mit Abscheidung von Me:a-C:H Dünnschichten
- 4 Targets gewinkelt zum Substrat angeordnet
- rotierender Substratteller für möglichst homogene Beschichtung

